

ベクトル解析・物理数学1 追試験問題

具体的な計算過程も全て記すこと。

I. $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ とし, $\mathbf{H} = (H_x, H_y, H_z)$ を定数ベクトル (成分が x, y, z に依存しない) とする。

1. $\mathbf{H} \times \mathbf{r}$ の x, y, z 成分を求めよ。
2. 以下の微分演算の結果がスカラーかベクトルかを答え、その値を求めよ。
 - (1) $\nabla \times \mathbf{r}$ (2) $\nabla \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{r})$
 - (3) $\nabla \times (\mathbf{H} \times \mathbf{r})$ (4) $\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}$

II. C^2 級のベクトル場 \mathbf{A} について, 次のことを示せ。

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

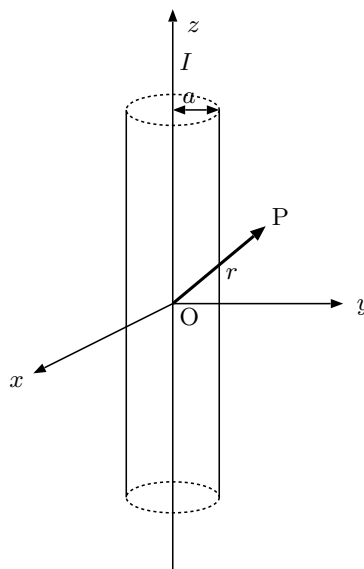
III. 無限に長い中空の円筒の表面に大きさ I の定常電流が流れている。ここで, 円筒の断面は, 半径 a の円であるとする。電流は円筒表面を一様に流れているとし, 円筒の中心軸を z 軸とする。また, 電流の向きを z 軸の正の方向とする。下図参照。

磁場を \mathbf{H} , 電流密度を \mathbf{i} としたとき, マクスウェルの方程式の一つは,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i} \tag{1}$$

で与えられる。点 P の円筒座標を $\mathbf{r} = (\rho, \phi, z)$ とし, 磁場 \mathbf{H} の円筒座標系での成分を H_ρ, H_ϕ, H_z とする。(図は, 点 P が円筒の外側にある場合。) マクスウェルの方程式 (1) を用い, さらにストークスの定理を適用して, 次の領域における磁場の成分 H_ρ, H_ϕ, H_z を求めよ。

- (a) 円筒の外側 ($a < \rho$) (b) 円筒の内側 ($\rho < a$)



IV. 真空中に置かれた半径 R の球殻を考える。球殻には電荷 Q が与えられている。電荷分布は一様であるとする。球の中心を原点 O として図のように座標系をとる。

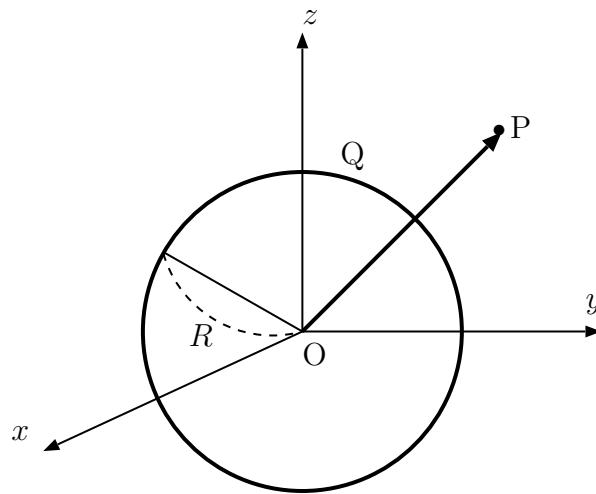
電場を \mathbf{E} 、電荷密度を ρ 、真空の誘電率を ε_0 としたとき、マックスウェルの方程式の一つは、

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

で与えられる。この式とガウスの定理を用いることにより、座標 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ の点 P における電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ の球座標系での成分、 E_r, E_θ, E_ϕ を

- (a) 球殻の外側 ($R < r$) (b) 球殻の内側 ($r < R$)

の場合について求めよ。ここで、 $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ である。



V. 円筒座標系において、曲線座標は $(q_1, q_2, q_3) = (\rho, \phi, z)$ である。以下の問いに答えよ。

1. デカルト座標系での座標 (x, y, z) を円筒座標系の座標 (ρ, ϕ, z) で表せ。
2. $i = 1, 2, 3$ について、 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ を計算せよ。
3. $\mathbf{f}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$, $h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$ とする。 h_1, h_2, h_3 を求めよ。また、 $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3$ は規格直交系をなすことを示せ。

VI. 次のことを証明せよ。

1. エルミート行列の固有値は実数である。
2. エルミート行列の異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する。